



一种深低温氧化物热敏电阻材料



妥万禄, 兰玉岐



2009-10-28

专利权人 中国科学院新疆理化技术研究所

授权日期 2013-11-27

授权国家 中国

专利类型 发明

摘要 本发明涉及一种深低温氧化物热敏电阻材料, 该材料是用碳酸锶或氧化锶和三氧化二钴进行直接固相反应或用硝酸盐采用化学方法合成非化学计量的钙钛矿结构氧化物 $\text{SrCoO}_{1-x}\text{Ni}_x\text{O}_{3-5}$ ($0 \leq \delta \leq 0.1$, $0 \leq \delta \leq 0.5$) 材料, 经测试其参数与已有的在液氧、液氮、液氢温度下使用的定型产品相比, 得出的元件可在4.2K-20K温度下使用, 且使用温区比较宽, 由于不含稀土元素也降低了成本。

申请日期 2005-09-30

专利号 ZL200510106550.2

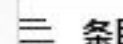
专利状态 授权

申请号 200510106550.2

文献类型 **专利**条目标识符 <http://ir.tianshanzw.cn/handle/365002/3049>

专题 材料物理与化学研究室

推荐引用方式 妥万禄, 兰玉岐. 一种深低温氧化物热敏电阻材料[P]. 2009-10-28. GB/T 7714



条目包含的文件

条目无相关文件。

所有评论 (0)

[\[发表评论/异议/意见\]](#)

暂无评论

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

个性服务

推荐该条目

★ 保存到收藏夹

📊 查看访问统计

📄 导出为Endnote文件

谷歌学术

📖 谷歌学术中相似的文章

📖 [妥万禄]的文章

📖 [兰玉岐]的文章

百度学术

📖 百度学术中相似的文章

📖 [妥万禄]的文章

📖 [兰玉岐]的文章

必应学术

📖 必应学术中相似的文章

📖 [妥万禄]的文章

📖 [兰玉岐]的文章

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享



QQ客服



官方微博



反馈留言